This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19) Japanese Intellectual Property Office (JP)

(12) Laid-Open Publication (A)

- (11) Laid-Open Publication No.: 61-32376
- (43) Laid-Open Publication Date: February 15, 1986
- (21) Application No.: 59-152417
- (22) Application Date: July 23, 1984
- (54) Title of invention:

METHOD FOR FABRICTING A HEATING ELEMENT HAVING POSITIVE RESISTANCE TEMPERATURE COEFFICIENT

CLAIM

A method for fabricating a heating element having a constant resistance temperature coefficient, wherein an electron beam is irradiated to a mixture of a crystalline resin and a conductive material and an amorphous portion of the crystalline resin is bridged.

⑩ 日本国特許庁(IP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-32376

@Int_Cl.4

識別記号

广内整理番号

昭和61年(1986)2月15日 63公開

H 05 B 3/10 7/02 7708-3K 6918-5E

未請求 発明の数 1 (全3頁)

正抵抗温度係数を有する発熱体の製造方法 匈発明の名称

> 到特 顧 昭59-152417

願 昭59(1984)7月23日 20世

切発 明 者 雨 宮 īF 世 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

勿発 明 者 平 #

幸 伸

門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社内

创出 顖 松下電器產業株式会社

門真市大字門真1006番地

四代 理

弁理士 中尾 ム 男 外1名

1、発明の名称

正抵抗温度保数を有する発熱体の製造方法

2、特許額求の範囲

(1) 結晶性樹脂に真正物を虚顔した虚顔物を熟処 理して得られた発熱体に電子線を照射し、前記結 晶性樹脂の内の非結晶部分を架橋した正抵抗温度 保数を有する発熱体の製造方法。

(2) ポリエチレンにカーポンを混練して混欺物を 作り、前記混紋物を融点以上で加熱し冷却を行っ た際、前記混煉物に電子線照射し非結晶部分を架 綴した特許請求の範囲第1項記載の正抵抗温度保 数を有する発熱体の製造方法。

低密度ポリエチレンに6~108のアセチレ ンプラックカーボンを混練し、前記混凝物を.150 ~190℃、1~2時間熱処理し、8℃/min 以下の冷却速度で冷却後、8メガラッド以上の電 子原照射し、非結晶部分を架器し高温時安定と、 非可逆性とした特許請求の範囲第1項記載の正抵 抗温皮保致を有する発然体の製造方法。

4) 低密度ポリエチレンに10~20多のアセチ レンプラックカーボンを混練して混練物を作り、 前記混練物を150~190℃、1~2時間熱処 理し、8℃/min 以下の冷却速度で冷却後、10 メガラッド以下の電子線照射し、非結晶部分の架 機した高温時安定と可逆性とした特許請求の範囲 第1項記憶の正抵抗温度係数を有する発熱体の製 造方法。

3、発明の詳細な説明

産菜上の利用分野

本発明は正抵抗温度保致を育する発熱体の製造 方法に関し、特にその高温時の安定性に関するも のである。

従来例の構成とその問題点

近年、自己温度制御用ヒータとして正抵抗温度 係数を有する発熱体が注目されている。

以下、図面を参照しながら、上述したような従 来の正抵抗温度保強を有する発熱体について説明

第1図は従来のポリエチレン樹脂にカーボンを

促
応した正抵抗
品皮保数を有する発熱体の
温度と
抵抗の変化を示するのである。第1図にかいて、
1は室温より温度の上昇に伴い、抵抗が増加して
いる部分である。2は樹脂の
耐点近くで抵抗が
20~500MΩ
程度
の値を保つ。4は樹脂が溶剤状態になり、抵抗値
が急激に低下し常温初期抵抗値に近づく。5は常温になった時の抵抗値である。

以上のように従来の正抵抗温度保扱を有する発然体について、その動作について説明した。

上記の様な特性では、抵抗体が外部の熱の影響 により、120~150℃以上になった時は、抵 抗が低下し、負抵抗温度保效の特性となり、更に 外部よりの熱で温度が上昇する危険性を有してい た。

発明の目的

本発明は上記欠点に鑑み、高温時、樹脂の容融 により樹脂内のカーボンが自由に動いて、抵抗を 下がるのを、架器によって抑制することを目的に している。カーボンの含量と電子線照射量を制御

線照射を行って得られた発熱体の特性図である。
1 は室温より丹温するとともに上昇する抵抗値を示す。2 は低密度ポリエチレンの軟化点である。
軟化点で急激に抵抗は上昇しる、1.000MΩ程
度の値になり、190℃迄の丹温にも抵抗の低下
は見られない4。発熱体を冷却して行って室温迄
下げても上記条件で作成したものは非可逆性で室
温になっても5、1.000MΩの値を示す。

以下本発明の第2の実施例について第3図をお照しなから説明する。低密皮ボリエチレンに89のアセチレンプラックを選択し、前記混箪物を190℃、2時間の雰囲気を保った後、4℃㎡にの合却速度で窒温迄冷却、前記熱処理した混綵物を5メガラッドの電子線照射を行って得られた発熱体の特性図である。1は窒温より丹温抵抗増加を示す。2は低密皮ボリエチレンの軟化点で急強に抵抗増加し、3で1000MΩの値を示す
180℃迄4、抵抗は流を示す。冷却は軟化点100℃を過ぎると低下し室温迄もどろと可覚

性を示す。高温部では完全な高抵抗を示すが初期

することにより発熱体の抵抗値を高温時、常温時 間を可逆,非可逆にすることが出来る。

発明の構成

この目的を選成するために本発明の正抵抗温度 保数を有する発熱体は、結晶性樹脂に再近性物を 混凝した混錬物を熱処理し結晶内と非結晶部分に 再電物による再延通路を得た後に、近子線架器を 行い、再近物を架器によって、固定することによ って、高温時でも容易に再短回路が安定してかり 抵抗の低下を抑えると同時に熱による変形をも防 止出来る。

突施例の説明

以下本発明の一突施例について図面を容照したがら説明する。第2図は本発明の第1の実施例における正抵抗温度保査を有する発燃体の温度と抵抗の特性を示すものである。低密度ポリエチレンに8ヵのアセチレンファックを混煉し、前記混綵物を190℃、2時間の雰囲気を保った後、4℃/min の冷却速度で室温迄冷却する。

前記熱処理した混雑物を10メガラッドの電子

の無上げ前よりもやや高目の抵抗を示す特徴がある。

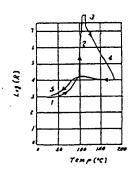
発明の効果

以上のように本発明は、結晶性樹脂に導電物の 個人の割合と熱処理条件及び電子線照射量を制御 することによって高温時に安定でかつ抵抗の可逆 性のもの、非可逆性のものが得られ、正温度保役 を有する発熱体の信頼性(高温時の)が飛躍的向 上することが出来、その効果は大なるものがある。

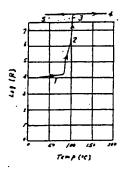
4、図面の簡単な説明

第1図は従来の発然体の温度と抵抗の特性図、 第2図、第3図、第4図はそれぞれ本発明の各実 施例の発熱体の温度と抵抗の特性図である。

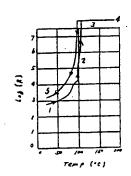
1 ……室温より昇温している抵抗変化、2 …… 樹脂の軟化点で抵抗が急上昇する抵抗値、3 …… 高温部で抵抗無限(1000MΩ)になった状態、 4 ……180℃迄到達した抵抗値、5 ……高温上 り冷却して室温迄もどした発熱体の抵抗値。 代现人の氏名 井理士 中 尾 敏 男 ほか1名 孫 1 図

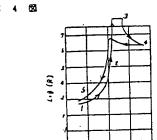


746 2 200



第 3 図





Temp (°C)